

DOCKET NO.: 263592US2PCT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Jean-Louis OUVRIER-BUFFET, et al.

SERIAL NO.: NEW U.S. PCT APPLICATION

FILED: HERewith

INTERNATIONAL APPLICATION NO.: PCT/FR03/02035

INTERNATIONAL FILING DATE: July 1, 2003

FOR: DEVICE FOR HOLDING AN OBJECT UNDER A VACUUM AND PROCESSES FOR MAKING THIS DEVICE, APPLICATION TO UNCOOLED INFRARED DETECTORS

**REQUEST FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION**

Commissioner for Patents
Alexandria, Virginia 22313

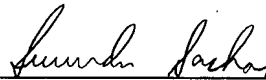
Sir:

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicant claims as priority:

<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NO</u>	<u>DAY/MONTH/YEAR</u>
France	02 08293	03 July 2002

Certified copies of the corresponding Convention application(s) were submitted to the International Bureau in PCT Application No. PCT/FR03/02035. Receipt of the certified copy(s) by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.

Respectfully submitted,
OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.



Marvin J. Spivak
Attorney of Record
Registration No. 24,913
Surinder Sachar
Registration No. 34,423

Customer Number

22850

(703) 413-3000
Fax No. (703) 413-2220
(OSMMN 08/03)

BEST AVAILABLE COPY



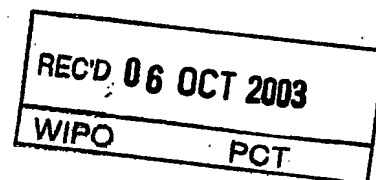
PCT/FR 07/02035

Rec'd PCT/PTO 29 DEC 2004

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE



Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 22 SEP. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

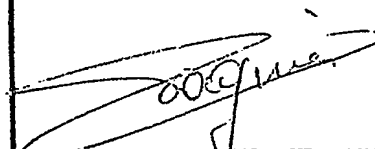
SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 W / 26089

REMISE DES PIÈCES DATE 3 JUIL 2002 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT 0208293 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI - 3 JUIL. 2002		1. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE BREVATOME 3 rue du Docteur Lancereaux 75008 PARIS	
Vos références pour ce dossier (facultatif) B 14062.3/PV DD2326			
Confirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
2. NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
<i>Demande de brevet initiale</i> N° _____ Date ____/____/____			
<i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i> N° _____ Date ____/____/____			
Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i> <input type="checkbox"/> N° _____ Date ____/____/____			
3. TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) DISPOSITIF DE MAINTIEN D'UN OBJET SOUS VIDE ET PROCEDES DE FABRICATION DE CE DISPOSITIF, APPLICATION AUX DETECTEURS INTRAROUGES NON REFROIDIS.			
4. DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5. DEMANDEUR		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE	
Prénoms			
Forme juridique		Etablissement public de caractère Scientifique, Technique et Industriel	
N° SIREN			
Code APE-NAF			
Adresse	Rue	31-33 rue de la Fédération	
	Code postal et ville	75752	PARIS 15ème
Pays		FRANCE	
Nationalité		FRANCAISE	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			

REMISE DES PIÈCES DATE 3 JUIL 2002 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT 0208293 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI		DB 540 W / 260399	
Vos références pour ce dossier : <i>(facultatif)</i>			B 14062.3/PV DD2326		
6 MANDATAIRE					
Nom			LEHU		
Prénom			Jean		
Cabinet ou Société			BREVATOME 422.5/S002		
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			7068 du 12.06.98		
Adresse	Rue		3 rue du Docteur Lancereaux		
	Code postal et ville		75008	PARIS	
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>			01.53.83.94.00		
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>			01.45.63.83.33		
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>			brevets.patents@brevallex.com		
7 INVENTEUR (S)					
Les inventeurs sont les demandeurs			<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée		
8 RAPPORT DE RECHERCHE					
Établissement immédiat ou établissement différé			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Paiement échelonné de la redevance			Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES			Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention <i>(joindre un avis de non-imposition)</i> <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt <i>(joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence)</i> :		
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes					
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) J. LEHU 422-5 S/002				VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI 	

DISPOSITIF DE MAINTIEN D'UN OBJET SOUS VIDE ET PROCÉDES
DE FABRICATION DE CE DISPOSITIF, APPLICATION AUX
DETECTEURS INFRAROUGES NON REFROIDIS

5

DESCRIPTION

DOMAINE TECHNIQUE

La présente invention concerne un dispositif de maintien d'un objet sous vide ainsi que des procédés de fabrication de ce dispositif.

10

Elle s'applique notamment au maintien sous vide d'un détecteur infrarouge non refroidi ou d'un ensemble de tels détecteurs.

15

Un détecteur infrarouge non refroidi comporte généralement un élément sensible qui peut être chauffé par un rayonnement infrarouge dans la bande II ($3\mu\text{m}$ à $5\mu\text{m}$) ou dans la bande III ($8\mu\text{m}$ à $12\mu\text{m}$), caractéristique de la température et de l'émissivité des corps observés. L'augmentation de la température de l'élément sensible engendre une variation d'une propriété électrique du matériau de cet élément sensible.

20

On observe par exemple l'apparition de charges électriques par effet pyroélectrique, ou une variation de capacité par changement de la constante diélectrique, ou encore une variation de la résistance du matériau qui peut être semi-conducteur ou métallique.

25

Un fonctionnement performant d'un détecteur infrarouge non refroidi nécessite que trois conditions

principales soient satisfaites en ce qui concerne le matériau de l'élément sensible :

- ce dernier doit avoir une faible masse calorifique,

5 - une bonne isolation thermique doit exister entre la couche active de cet élément et le support de cette couche active, les deux premières conditions impliquant une utilisation de couches minces, et

10 - il doit exister une forte sensibilité de l'effet de conversion de l'échauffement en un signal électrique.

Des imageurs infrarouges monolithiques fonctionnant à température ambiante sont fabriqués en connectant directement une matrice d'éléments sensibles à un circuit de multiplexage en silicium de type CMOS ou CCD.

Un détecteur thermique peut être encapsulé sous vide ou sous un gaz peu conducteur de la chaleur pour augmenter les performances de ce détecteur. Le boîtier d'encapsulation comporte alors une fenêtre transparente dans la bande III.

L'opération d'intégration dans un boîtier, ou micro-boîtier, classique est délicate en ce qui concerne son rendement et, de plus, elle est relativement coûteuse. Aussi des techniques d'encapsulation collective ont-elles été proposées pour pallier ces difficultés.

Cependant, ces techniques présentent également des limitations qu'il convient de prendre en

compte pour réduire les coûts et améliorer la durée de vie des micro-boîtiers d'encapsulation.

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE

5 Dans le domaine de l'encapsulation collective sous vide de détecteurs infrarouges non refroidis, on cherche des techniques d'encapsulation permettant d'améliorer significativement le rendement d'intégration des détecteurs, tout en conservant un
10 haut niveau de performance de ceux-ci et en réduisant leur coût.

On se reportera au document suivant :

[1] US 5 895 233A, Higashi et al.,
Integrated silicon vacuum micropackage for infrared
15 devices.

Ce document divulgue l'encapsulation collective de dispositifs infrarouges (émetteurs ou détecteurs) par couplage d'une tranche ("wafer") de tels dispositifs avec une tranche de fenêtres
20 transparentes au rayonnement infrarouge, afin de réaliser une micro-encapsulation sous vide ou sous un gaz peu conducteur de la chaleur.

Parmi les avantages potentiels de cette technique connue figurent le coût et l'encombrement
25 réduit. En effet, ce dernier se limite typiquement à l'épaisseur de deux tranches de silicium.

La liaison entre les deux tranches est réalisée préférentiellement par un cordon, ou film, de soudure qui d'une part assure l'étanchéité et d'autre
30 part détermine, selon son épaisseur, l'écartement entre les deux composants du micro-boîtier que l'on forme.

Le film de soudure résulte d'un dépôt sous vide, par la technique de pelage ("lift off"), ou d'une gravure après dépôt du matériau de soudure. Ce film peut provenir d'une préforme convenablement positionnée.

Pour maintenir une pression résiduelle acceptable à l'intérieur du micro-boîtier, il est nécessaire d'employer des matériaux dont le taux de dégazage n'est pas excessif.

Cependant, même avec un taux de dégazage relativement faible, il est utile, voire obligatoire, d'introduire un matériau getter dans le micro-boîtier pour adsorber les gaz émis par les différentes surfaces qui s'y trouvent car l'accroissement de la pression dégrade l'isolation thermique des micro-ponts que comportent les dispositifs encapsulés.

A cet effet, on propose, dans le document [1], d'introduire dans le micro-boîtier, sur le circuit détecteur ou émetteur ou sur les fenêtres, des films de baryum, de vanadium, de fer, de zirconium, ou d'alliages de ces matériaux.

Pour être rendus actifs, de tels matériaux doivent être portés à haute température pendant une courte période, soit par effet Joule soit par un faisceau laser, sans toutefois chauffer outre mesure les dispositifs détecteurs ou émetteurs ni les fenêtres.

Il est avantageusement suggéré de déposer un matériau getter, plus simplement appelé "getter", sur des micro-ponts réservés à cet usage, afin de

confiner l'échauffement uniquement à ce matériau getter.

Cependant, l'emploi de getters pour obtenir le vide et assurer son maintien, vide qu'il convient également de confiner pour limiter l'éventuelle pollution des éléments sensibles tels que les micro-ponts, accroît la surface des puces ("chips") de détection (ou d'émission) au détriment du nombre de puces par tranche, et ce d'autant plus qu'il est difficile de les activer avec un bon rendement sans dépasser la température acceptable par le circuit de détection (ou d'émission), ce qui est donc compensé par un volume ou une surface de getter plus important.

Ainsi, dans la technique connue par le document [1], les getters utilisés prennent de la place et ne permettent pas une miniaturisation suffisante.

Typiquement, la longueur et la largeur des cavités, dont il est question dans le document [1], sont sensiblement égales et comprises entre quelques millimètres et quelques dizaines de millimètres, et la hauteur de ces cavités va de quelques micromètres à quelques centaines de micromètres selon le cas.

Ces petites dimensions ne permettent pas d'utiliser les moyens classiques d'incorporation du matériau getter (par exemple queusot en métal ou en verre, contenant ce matériau, ou filament de ce matériau placé dans le micro-boîtier et activé par effet Joule).

De plus, la technique divulguée par le document [1] est unitaire et coûteuse.

EXPOSÉ DE L'INVENTION

La présente invention a pour but de remédier aux inconvénients résultant de l'utilisation que l'on fait des getters dans cette technique du document [1].

L'invention permet d'intégrer, de manière collective, un matériau getter dans le procédé de fabrication de dispositifs de détection infrarouge non refroidis, de manière à réduire le coût de ces dispositifs.

L'invention consiste à placer le matériau getter en dessous du circuit de lecture associé aux détecteurs, ce qui ne fait pas perdre de place, et à relier ce matériau, par au moins un passage aussi petit que possible, à la cavité où le vide doit être maintenu.

L'utilisation de la face inactive du circuit de lecture, communément appelée "face arrière", permet de mettre en œuvre un procédé de fabrication plus avantageux en termes de coût de production.

Plus généralement, la présente invention propose un dispositif et des procédés de fabrication de celui-ci, permettant de maintenir un objet sous vide dans une cavité sans encombrer cette dernière.

De façon précise, la présente invention concerne un dispositif de maintien d'un objet sous vide, ce dispositif comprenant une cavité étanche, qui contient l'objet et dans laquelle est fait le vide, cette cavité étant délimitée par un premier support, dont une première face forme le fond de la cavité, et par un deuxième support qui est fixé à cette première

face de façon étanche, le dispositif comprenant en outre un getter destiné à piéger des gaz susceptibles de se trouver dans la cavité,

ce dispositif étant caractérisé en ce que
5 le getter est placé à l'extérieur de la cavité et contenu dans un logement étanche qui est relié à cette cavité par au moins un passage étanche.

Selon un mode de réalisation particulier du dispositif objet de l'invention, la première face du
10 premier support porte de l'objet.

Selon un autre mode de réalisation particulier, la première face du premier support porte l'objet, ce dernier étant un émetteur ou un récepteur de rayonnement infrarouge non refroidi ou un ensemble
15 de tels émetteurs ou récepteurs, et le deuxième support est apte à laisser passer le rayonnement infrarouge.

Selon un mode de réalisation préféré du dispositif objet de l'invention, le logement est formé dans une deuxième face du premier support, opposée à la
20 première face, et le passage étanche est formé à travers le premier support pour relier le logement à la cavité.

De préférence, le logement est hermétiquement fermé par au moins une couche d'un
25 matériau étanche.

Les parois du logement sont de préférence recouvertes d'au moins une couche de protection du premier support vis-à-vis du getter.

Cette couche de protection peut être faite
30 d'un matériau choisi parmi SiO_2 , SiN et Si_3N_4 .

Le getter peut être fait à partir d'un matériau choisi parmi le titane, le molybdène, le baryum, le tantale, le zirconium, le fer et le vanadium.

5 La présente invention concerne aussi un procédé de fabrication du dispositif de l'invention, dans lequel

- on forme l'objet sur la première face du premier support,
- 10 - on forme le logement dans la deuxième face de ce premier support,
- on forme le getter dans ce logement,
- on enferme hermétiquement le getter dans ce logement,
- 15 - on forme le passage à travers le premier support,
- on met sous vide l'ensemble ainsi obtenu,
- on fixe, de façon étanche, sous vide, le deuxième support à la première face du premier support,
- 20 et
- on active le getter.

La présente invention concerne en outre un procédé de fabrication du dispositif de l'invention, dans lequel

- 25 - on forme l'objet sur la première face du premier support,
- on forme le logement dans la deuxième face de ce premier support,
- on forme le getter dans ce logement,
- 30 - on forme le passage à travers le premier support,

- on fixe de façon étanche, sous une atmosphère quelconque, le deuxième support à la première face du premier support,

- on met sous vide l'ensemble ainsi obtenu,
5 par pompage à travers le getter et le passage,

- on enferme hermétiquement le getter dans le logement, et

- on active le getter.

La présente invention concerne aussi un
10 autre procédé de fabrication du dispositif de l'invention, dans lequel l'objet est un composant comprenant un émetteur ou un récepteur de rayonnement infrarouge non refroidi, ou une pluralité de tels composants, le deuxième support étant apte à laisser
15 passer le rayonnement infrarouge, un circuit de lecture étant associé à ce composant ou à cette pluralité de tels composants et formé sur le premier support, et dans lequel

- on forme le logement dans la deuxième
20 face du premier support,

- on forme le circuit de lecture et l'on forme le getter dans le logement, pendant des étapes initiales de formation du circuit de lecture, ces étapes initiales supportant une haute température, mais
25 avant des étapes finales de formation du circuit de lecture,

- on forme l'objet sur la première face du premier support,

- on enferme hermétiquement le getter dans
30 le logement,

- on forme le passage à travers le premier support,

- on met sous vide l'ensemble ainsi obtenu,

- on fixe de façon étanche, sous vide, le
5 deuxième support à la première face du premier support;
et

- on active le getter.

La présente invention concerne en outre un
autre procédé de fabrication du dispositif de
10 l'invention, dans lequel l'objet est un composant
comprenant un émetteur ou un récepteur de rayonnement
infrarouge non refroidi, ou une pluralité de tels
composants, le deuxième support étant apte à laisser
passer le rayonnement infrarouge, un circuit de lecture
15 étant associé à ce composant ou à cette pluralité de
tels composants et formé sur le premier support, et
dans lequel

- on forme le logement dans la deuxième
face du premier support,

20 - on forme le circuit de lecture et l'on
forme le getter dans le logement, pendant des étapes
initiales de formation du circuit de lecture, ces
étapes initiales supportant une haute température, mais
avant des étapes finales de formation du circuit de
25 lecture,

- on forme l'objet sur la première face du
premier support,

- on forme le passage à travers le premier
support,

- on fixe de façon étanche, sous une atmosphère quelconque, le deuxième support à la première face du premier support,

- on met sous vide l'ensemble ainsi obtenu,
5 par pompage à travers le getter et le passage,

- on enferme hermétiquement le getter dans le logement et

- on active le getter.

10 BRÈVE DESCRIPTION DU DESSIN

La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la description d'exemples de réalisation donnés ci-après, à titre purement indicatif et nullement limitatif, en faisant référence à la figure
15 unique annexée qui est une vue en coupe schématique et partielle d'un mode de réalisation particulier du dispositif objet de l'invention.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION PARTICULIERS

20 Dans un exemple de l'invention, on veut maintenir sous vide un ensemble de composants constitués par des détecteurs ou des émetteurs infrarouges non refroidis, élaborés sur la face active d'un circuit de lecture.

25 Conformément à un mode de réalisation préféré de l'invention, on utilise la face opposée à cette face active du circuit de lecture pour implanter le matériau getter.

Un ou plusieurs orifices, qui sont en
30 contact avec le matériau getter et débouchent dans la

cavité où se trouve l'ensemble des composants, permettent de créer et/ou de maintenir le vide dans celle-ci.

5 Ce concept prolonge l'utilisation systématique des techniques de la microélectronique sur un semi-conducteur tel que le silicium, jusqu'à l'étape de création de la cavité.

10 La notion de cavité s'entend au sens large, puisque l'on peut aussi bien s'intéresser à l'encapsulation collective d'un dispositif constitué de détecteurs qu'à l'encapsulation individuelle de détecteurs disposés sous la forme d'une matrice.

15 Cette approche concerne toutes les dimensions de boîtier sous vide. Cependant, elle est particulièrement adaptée aux boîtiers de très faibles dimensions, dans lesquels il est difficile d'introduire puis d'activer un getter solide à proximité du dispositif à encapsuler, sans détériorer ce dispositif.

20 La figure unique annexée est une vue en coupe schématique d'un objet encapsulé sous vide conformément à l'invention.

Cet objet est un ensemble d'éléments émetteurs ou détecteurs de rayonnement 2, par exemple des microbolomètres.

25 Cet ensemble est formé sur une première face d'un substrat semi-conducteur 4 comportant le circuit de lecture 5 associé aux éléments. La vue en coupe est prise dans un plan perpendiculaire à ce circuit de lecture.

30 Cette première face, ou face avant, est pourvue de métallisations telles que la métallisation

6, permettant de relier électriquement le circuit de lecture à l'ensemble des composants.

En plus du substrat 4, le dispositif permettant de maintenir l'ensemble des éléments 2 sous vide comprend un autre substrat 8, ou fenêtre, apte à laisser passer le rayonnement R destiné à être détecté ou émis par les éléments ou composants 2. Ce substrat 8 est fixé de façon étanche au substrat 4, par l'intermédiaire d'un cordon de scellement 10.

Plus précisément, le substrat 4 comporte une couche électriquement isolante 12 qui s'étend sur la face avant du substrat 4, autour de l'ensemble des composants 2 et au-dessus des métallisations, et le cordon de scellement 10 s'appuie sur cette couche isolante 12, comme on le voit sur la figure annexée.

En outre, le substrat 8 comporte un évidement 14 qui, lorsque ce substrat 8 est scellé au substrat 4, définit une cavité 16 contenant les composants 2.

Du côté de sa face arrière (qui est opposée à sa face avant), le substrat 4 comporte un évidement 18 qui s'étend sensiblement sous toute la zone occupée par la cavité 16.

Un matériau getter 22 est placé dans l'évidement 18. Une ou plusieurs couches de barrière 20 recouvrent les parois de l'évidement 18 et servent à protéger le matériau constitutif du substrat 4 vis-à-vis du matériau getter 22.

Une ou plusieurs autres couches de barrière 24 sont formées sur la face arrière du substrat 8 pour enfermer de façon étanche ce matériau getter 22 dans la

cavité qui est définie par l'évidement 18 et cette couche 24.

Conformément à l'invention, un ou plusieurs canaux 26 traversent le substrat 4 et la ou les couches de barrière 20 pour mettre en communication cette cavité et l'autre cavité 16, de manière à pouvoir maintenir le vide dans cette cavité 16 grâce au matériau getter.

On connaît divers procédés de fabrication de détecteurs ou émetteurs élémentaires de rayonnement infrarouge, tels que des microbolomètres par exemple, et il n'est pas nécessaire de les rappeler. Il convient cependant de noter que le procédé de fabrication utilisé pour fabriquer les composants 2 n'est pas toujours compatible avec la technologie d'implantation et de mise en œuvre du getter.

Rappelons qu'un getter, également appelé "fixateur de gaz", est un matériau poreux qui peut être transporté à l'air : une couche superficielle va se saturer et bloquer le phénomène de piégeage. Il suffit de chauffer ce matériau à une température spécifique pour que les impuretés piégées en surface diffusent vers le cœur du matériau pour rendre la surface à nouveau opérationnelle.

Dans l'invention, la surface du getter est calculée pour qu'elle puisse "absorber" toutes les impuretés susceptibles d'apparaître dans la cavité contenant le dispositif à maintenir sous vide (c'est à dire la cavité 16 contenant les composants 2 dans l'exemple représenté) au cours du fonctionnement de ce dispositif.

A la limite, si le getter venait quand même à être saturé, il suffirait de le réactiver par une nouvelle élévation adéquate de sa température pour obtenir un getter à nouveau efficace.

5 Un getter est élaboré à partir de matériaux qui, une fois activés, capturent les molécules de gaz résiduel. Ainsi, ils adsorbent, absorbent et/ou piègent les molécules de gaz émises par les parois de la cavité durant la vie du produit à maintenir sous vide.

10 Les matériaux getter préférés sont : le titane, le molybdène, le baryum, le tantale, le zirconium, le fer et le vanadium.

Ils se présentent le plus fréquemment sous la forme de poudres frittées ou de films réalisés par sérigraphie. L'élaboration de tels matériaux implique
15 alors un recuit autour de 800°C dans un four à ultravide.

Ces matériaux peuvent être également déposés en couches minces par les techniques usuelles de la microélectronique, telles que l'évaporation et la
20 pulvérisation.

Ces matériaux sont alors activés in situ car, une fois éjectés de la source ou de la cible dans le vide, ils ne rencontrent pas d'autres espèces sur
25 leur parcours. Ils doivent donc être parfaitement encapsulés pour préserver leur efficacité de pompage après remise à l'air.

Le matériau getter 22 de la figure annexée est déposé dans la cavité correspondante par l'une des
30 techniques mentionnées ci-dessus. Préalablement le matériau semi-conducteur du substrat 4 qui supporte le

circuit de lecture est, comme on l'a vu, protégé par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs couches-barrières par exemple constituées de SiO_2 , SiN ou Si_3N_4 .

Une fois déposé, et si cela est nécessaire,
5 le matériau getter est planarisé par des techniques connues de l'homme du métier, telles qu'un polissage mécanique, mécano-chimique ou électrochimique, avant ou après un recuit sous vide.

10 Finalement le matériau est encapsulé par une ou plusieurs couches-barrières afin de le protéger définitivement de l'atmosphère ambiante.

Selon son mode de fabrication, l'intégration du getter sur la face arrière du substrat portant le circuit de lecture est réalisée durant les
15 phases de traitement de face avant ou de face arrière du procédé de fabrication de l'ensemble.

Le traitement de face arrière est constitué d'étapes technologiques qui peuvent se dérouler à de hautes températures, tandis que le traitement de face
20 avant ne peut supporter et ne nécessite que des traitements thermiques qui ne dépassent pas 450°C et incluent, par exemple, la fabrication de détecteurs non refroidis.

Il est donc impératif d'introduire
25 judicieusement les étapes d'intégration du getter dans le procédé de fabrication de l'ensemble afin d'obtenir des matériaux getter de grande qualité et de ne détériorer ni les composants 2 ni les circuits de lecture.

30 Un détecteur thermique encapsulé sous vide conformément à l'invention est constitué du micro-

boîtier décrit précédemment (assemblage des substrats et du getter), conduisant à un composant optimisé en termes d'encombrement et de coût.

Les éléments de ce détecteur peuvent avoir
5 une architecture matricielle, permettant de faire de l'imagerie infrarouge.

Dans un mode de réalisation préféré, un procédé de fabrication conforme à l'invention conserve un aspect collectif jusqu'au composant terminé, intégré
10 dans un micro-boîtier sous vide.

Pour réaliser un assemblage collectif, on utilise deux substrats :

- une tranche ("wafer") de détecteurs infrarouges non refroidis sur un circuit de lecture en
15 silicium, tranche au dos de laquelle est pratiqué un évidement qui est ensuite rempli d'un matériau getter, et

- une tranche de fenêtre pour rayonnement infrarouge (par exemple en Si, Ge ou ZnS).

20 Ces substrats sont préalablement élaborés séparément, en utilisant les techniques usuelles de la micro-électronique.

Ainsi les cavités dans la tranche de circuit de lecture et dans la tranche de fenêtre sont-
25 elles formées par des procédés de gravure chimique ou de gravure par plasma. De même, le ou les orifices permettant l'évacuation des gaz résiduels vers le getter sont formés par de tels procédés.

A titre purement indicatif et nullement
30 limitatif, l'épaisseur de la tranche de circuit de lecture se situe autour de 500 μ m, la profondeur des

cavités se situe entre $5\mu\text{m}$ et $200\mu\text{m}$ et l'épaisseur de la tranche de fenêtre est comprise entre $100\mu\text{m}$ et 2mm selon sa nature et le format des détecteurs.

Les matériaux métalliques (tels que Ti, 5 TiN, Pt, Al, Au, W, Ni, In, Sn, InPb, SnPb par exemple), qui constituent les plots métalliques d'interconnexion, les cordons de scellement et leur embases, sont déposés par pulvérisation cathodique, dépôt chimique en phase vapeur ("chemical vapour 10 deposition") ou évaporation.

Ces diverses métallisations sont définies par des procédés de gravure chimique ou de gravure par plasma ou par un procédé de pelage ("lift off").

Les couches de matériaux, qui sont 15 isolantes (couches de SiO_2 , SiN ou Si_3N_4 par exemple) et/ou constituent une barrière pour la diffusion, sont obtenues par décomposition thermique (LPCVD) ou par décomposition par plasma (PECVD). L'épaisseur de ces couches est par exemple comprise entre $0,05\mu\text{m}$ et $5\mu\text{m}$.

20 Pour obtenir N micro-boîtiers, une tranche portant N circuits de lecture et N ensembles de détecteurs élémentaires sur sa face avant et N cavités contenant du getter sur sa face arrière est scellée sous vide avec une tranche comportant N fenêtres, en 25 utilisant la technique la plus appropriée.

Après ce scellement, la découpe est effectuée deux fois afin de séparer les N micro-boîtiers :

- une première fois pour séparer les N 30 fenêtres et

- une deuxième fois pour séparer les N
boîtiers.

L'activation du getter est effectuée in
situ, lors du scellement, ou avant découpe ou après
5 découpe, de façon qu'à l'issue de cette phase
d'activation, le niveau de vide (pression résiduelle)
dans la cavité soit inférieur ou égal à 1Pa.

Donnons encore des exemples de procédés
conformes à l'invention, permettant la fabrication du
10 dispositif de la figure annexée.

Dans un premier exemple,

- on forme les éléments 2 sur la face avant
du substrat 4,
- on forme l'évidement 18 muni de la couche
15 20 dans la face arrière de ce substrat 4,
- on forme le getter 22 dans cet évidement,
- on enferme hermétiquement le getter dans
ce dernier par la couche 24,
- on forme le ou les canaux 26 à travers le
20 substrat 4,
- on met sous vide l'ensemble ainsi obtenu,
- on scelle le substrat 8 à la face avant
du substrat 4 et
- on active le getter.

25 Dans un deuxième exemple,

- on forme les éléments 2 sur la face avant
du substrat 4,
- on forme l'évidement 18 muni de la couche
28 dans la face arrière de ce substrat 4,
- 30 - on forme le getter 22 dans cet évidement,

- on forme le ou les canaux 26 à travers le substrat 4,
- on scelle le substrat 8 à la face avant du substrat 4 sous une atmosphère quelconque,
- 5 - on met sous vide l'ensemble ainsi obtenu par pompage à travers le getter 22,
- on enferme hermétiquement le getter dans son évidement par la couche 24, et
- on active le getter.
- 10 Dans un troisième exemple,
- on forme l'évidement 18 muni de la couche 20 dans la face arrière du substrat 4,
- on forme le circuit de lecture 5 et l'on forme le getter 22 dans l'évidement pendant des étapes
- 15 initiales de formation du circuit de lecture 5, ces étapes initiales supportant une haute température, mais avant des étapes finales (métallisation) de formation du circuit de lecture,
- on forme les éléments 2, sur la face
- 20 avant du substrat 4,
- on enferme hermétiquement le getter dans l'évidement par la couche 24,
- on forme le ou les canaux 26 à travers le
- 25 substrat 4,
- on met sous vide l'ensemble ainsi obtenu,
- on scelle le substrat 8 à la face avant du substrat 4 et
- on active le getter.
- 30 Dans un quatrième exemple,

- on forme l'évidement 18 muni de la couche 20 dans la face arrière du substrat 4,

5 - on forme le circuit de lecture 5 et l'on forme le getter 22 dans l'évidement pendant des étapes initiales de formation du circuit de lecture 5, ces étapes initiales supportant une haute température, mais avant des étapes finales (métallisation) de formation du circuit de lecture,

10 - on forme les éléments 2, sur la face avant du substrat 4,

- on forme le ou les canaux 26 à travers le substrat 4,

- on scelle le substrat 8 à la face avant du substrat 4 sous une atmosphère quelconque,

15 - on met sous vide l'ensemble ainsi obtenu par pompage à travers le getter 22,

- on enferme hermétiquement le getter dans son évidement par la couche 24, et

- on active le getter.

20 Pour activer le getter hermétiquement enfermé dans sa cavité, on le chauffe à une température compatible avec les différents éléments du dispositif (circuit de lecture, composants, cordon de scellement).

25 La présente invention n'est pas limitée au maintien sous vide de détecteurs infrarouges non refroidis.

Tous les détecteurs de rayonnement ainsi que les capteurs mesurant des grandeurs physiques et
30 les dispositifs qui doivent fonctionner sous un vide

plus ou moins poussé peuvent profiter d'une
encapsulation conforme à l'invention.

REVENDEICATIONS

1. Dispositif de maintien d'un objet sous vide, ce dispositif comprenant une cavité étanche (16), qui contient l'objet (2) et dans laquelle est fait le vide, cette cavité étant délimitée par un premier support (4), dont une première face forme le fond de la cavité, et par un deuxième support (8) qui est fixé à cette première face de façon étanche, le dispositif comprenant en outre un getter (22) destiné à piéger des gaz susceptibles de se trouver dans la cavité,

ce dispositif étant caractérisé en ce que le getter (22) est placé à l'extérieur de la cavité (16) et contenu dans un logement étanche (18) qui est relié à cette cavité par au moins un passage étanche (26).

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel la première face du premier support (4) porte l'objet (2).

3. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel la première face du premier support (4) porte l'objet (2), ce dernier étant un émetteur ou un récepteur de rayonnement infrarouge non refroidi, ou un ensemble de tels émetteurs ou récepteurs, et le deuxième support (8) est apte à laisser passer le rayonnement infrarouge (R).

4. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel le logement (18) est formé dans une deuxième face du premier support (4), opposée à la première face, et le passage étanche (26) est formé à travers le premier support (4) pour relier le logement (18) à la cavité (16).

5. Dispositif selon la revendication 4, dans lequel le logement (18) est hermétiquement fermé par au moins une couche (24) d'un matériau étanche.

6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 4 et 5, dans lequel les parois du logement (18) sont recouvertes d'au moins une couche (20) de protection du premier support (4) vis-à-vis du getter (22).

7. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 4 à 6, dans lequel cette couche de protection (20) est faite d'un matériau choisi parmi SiO , SiN et Si_3N_4 .

8. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, dans lequel le getter (22) est fait à partir d'un matériau choisi parmi le titane, le molybdène, le baryum, le tantale, le zirconium, le fer et le vanadium.

9. Procédé de fabrication du dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans lequel

- on forme l'objet (2) sur la première face du premier support (4),

- on forme le logement (18) dans la deuxième face de ce premier support (4),

- on forme le getter (22) dans ce logement,

- on enferme hermétiquement le getter dans ce logement,

- on forme le passage (26) à travers le premier support,

- on met sous vide l'ensemble ainsi obtenu,

- on fixe de façon étanche, sous vide, le deuxième support (8) à la première face du premier support, et

- on active le getter (22).

5 10. Procédé de fabrication du dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans lequel

- on forme l'objet (2) sur la première face du premier support (4),

10 - on forme le logement (18) dans la deuxième face de ce premier support (4),

- on forme le getter (22) dans ce logement,

- on forme le passage (26) à travers le premier support (4),

15 - on fixe de façon étanche, sous une atmosphère quelconque, le deuxième support (8) à la première face du premier support,

- on met sous vide l'ensemble ainsi obtenu, par pompage à travers le getter et le passage,

20 - on enferme hermétiquement le getter (22) dans le logement (18), et

- on active le getter (22).

11. Procédé de fabrication du dispositif selon la revendication 1, dans lequel l'objet est un
25 composant comprenant un émetteur ou un récepteur de rayonnement infrarouge non refroidi, ou une pluralité de tels composants, le deuxième support (8) étant apte à laisser passer le rayonnement infrarouge (R), un circuit de lecture étant associé à ce composant ou à
30 cette pluralité de tels composants et formé sur le premier support, et dans lequel

- on forme le logement (18) dans la deuxième face du premier support (4),
- on forme le circuit de lecture et l'on forme le getter (22) dans le logement, pendant des
5.....étapes initiales de formation du circuit de lecture, ces étapes initiales supportant une haute température, mais avant des étapes finales de formation du circuit de lecture,
- on forme l'objet (2) sur la première face
10 du premier support,
- on enferme hermétiquement le getter dans le logement,
- on forme le passage (26) à travers le premier support,
- 15 - on met sous vide l'ensemble ainsi obtenu,
- on fixe de façon étanche, sous vide, le deuxième support (8) à la première face du premier support, et
- on active le getter (22).
- 20 12. Procédé de fabrication du dispositif selon la revendication 1, dans lequel l'objet est un composant comprenant un émetteur ou un récepteur de rayonnement infrarouge non refroidi, ou une pluralité de tels composants, le deuxième support (8) étant apte
25 à laisser passer le rayonnement infrarouge (R), un circuit de lecture étant associé à ce composant ou à cette pluralité de tels composants et formé sur le premier support, et dans lequel
- on forme le logement (18) dans la
30 deuxième face du premier support (4),

- on forme le circuit de lecture et l'on forme le getter (22) dans le logement, pendant des étapes initiales de formation du circuit de lecture, ces étapes initiales supportant une haute température, 5 mais avant des étapes finales de formation du circuit de lecture,

- on forme l'objet (2) sur la première face du premier support,

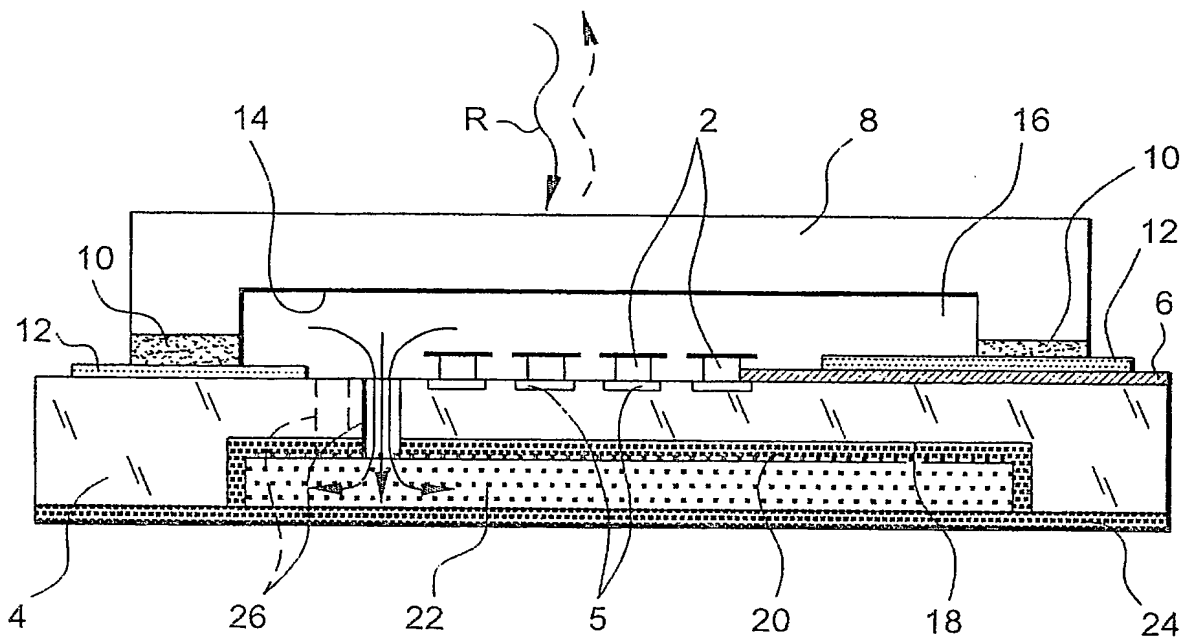
- on forme le passage (26) à travers le 10 premier support (4),

- on fixe de façon étanche, sous une atmosphère quelconque, le deuxième support (8) à la première face du premier support,

- on met sous vide l'ensemble ainsi obtenu, 15 par pompage à travers le getter et le passage,

- on enferme hermétiquement le getter (22) dans le logement (18), et

- on active le getter (22).



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08


Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1. / 1.

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 113 W / 260899

Vos références pour ce dossier (facultatif)		B 14062.3/PV DD2326	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0208293	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) DISPOSITIF DE MAINTIEN D'UN OBJET SOUS VIDE ET PROCEDES DE FABRICATION DE CE DISPOSITIF, APPLICATION AUX DETECTEURS INFRAROUGES NON REFROIDIS.			
LE(S) DEMANDEUR(S) : COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 31/33 rue de la Fédération 75752 PARIS 15ème			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		OUVRIER-BUFFET	
Prénoms		Jean-Louis	
Adresse	Rue	La Planche	
	Code postal et ville	74320	SEVRIER
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		BISOTTO	
Prénoms		Sylvette	
Adresse	Rue	52 rue Thiers	
	Code postal et ville	38000	GRENOBLE
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		BECCIA	
Prénoms		Chantal	
Adresse	Rue	Rue Etienne de la Boétie Les Ruieres	
	Code postal et ville	38320	EYBENS
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) PARIS LE 3 Juillet 2002 J. LEHU 422-5/002			

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.